

H10W クラス H10 に包含される装置の一般的なパッケ - ジ, 相互接続, コネクタまたは他の構造上の細部 [2026.01]

注

注 [2026.01]

1. このサブクラスは以下のものを包含する:
 - a. 装置のパッケ - ジおよびそのパッケ - ジの部品;
 - b. チップ, ウェハ, 基板またはパッケ - ジ内の装置の相互接続;
 - c. パッケ - ジ内の装置のコネクタ;
 - d. チップ, ウェハ, 基板またはパッケ - ジ内の装置のその他の構造上の細部, 例: 集積装置の構成部品間における分離領域;
 - e. 動作中のパッケ - ジを支持するための分離可能な保持具;
 - f. 以下の (a) - (e) の観点の製造または処理;
- (1) サブクラス H10B に包含される装置に適用可能な場合;
- (2) サブクラス H10D に包含される装置に適用可能な場合, ただしサブグル - プ H10D62/00 または H10D64/00 に包含される半導体本体またはその電極を除く;
- (3) サブクラス H10B, H10D, H10F, H10H, H10K または H10N に包含される装置に一般的に適用可能な場合。

サブクラス内の索引

サブクラス内の索引

ステップ, ウェハまたは基板内の集積装置の構造上の細部
集積装置の構成部品間における半導体本体内の分離領域
H10W10/00
集積装置の高濃度にド - プされた埋め込み領域
H10W15/00
チップ, ウェハまたは基板内の相互接続.. H10W20/00
他に分類されない, 集積装置の一般的な部品
H10W29/00
チップ, ウェハ, 基板またはパッケ - ジに関する構造上の細部
熱保護または熱制御のための構成..... H10W40/00
装置の保護のための構成..... H10W42/00
インピ - ダンスを制御または整合させるための電氣的構成..... H10W44/00
装置に適用されるマ - ク..... H10W46/00
パッケ - ジに関する観点
パッケ - ジ基板; インタ - ポ - ザ; 再配線層
H10W70/00
パッケ - ジ内の相互接続またはコネクタ H10W72/00
封緘..... H10W74/00
容器; 充填物; シ - ル..... H10W76/00
動作中のパッケ - ジ化されたチップを支持するための, 分離可能な保持具
H10W78/00
チップ, ウェハまたは基板のダイレクトボンディング
H10W80/00
パッケ - ジの配置..... H20W90/00
このサブクラスの他のグル - プに包含されないパッケ - ジング方法..... H10W95/00
このサブクラスの他のグル - プに包含されない主題事項
H10W99/00

チップ, ウェハまたは基板内の集積装置の構造上の細部 [2026.01]

- | | |
|-----------|-------------------------------------|
| 10/00 | 集積装置の構成部品間における半導体本体内の分離領域 [2026.01] |
| E | エピタキシャルに特徴のあるもの |
| P | シリコンの多孔質化技術を利用したもの |
| R | イオン注入に特徴のあるもの |
| S | 寄生効果の防止に特徴のあるもの |
| Z | その他のもの |
| 10/00 101 | ・基板に垂直方向の分離, 例 .SOI |
| B | 接着型 SOI |
| C | 接続; 配線 |

- | | |
|---|-------------------------------|
| D | 単結晶絶縁膜 |
| E | エピタキシャル型; インブラ絶縁膜形成, 例 .SIMOX |
| F | 素子分離; 領域分離 |
| G | 半絶縁型, 例 .GaAs |
| H | 多結晶支持体 |
| L | 配置; レイアウト |
| P | 多結晶能動層; アモルファス層 |
| Q | 超格子 |
| R | 再結晶 |
| S | SOS |
| T | テスト; 検査 |
| Z | その他のもの |

- | | |
|-------|---|
| 10/10 | ・誘電材料を含む分離領域 [2026.01] |
| 10/13 | ・シリコンの局所酸化 [LOCOS] により形成されるもの, 例: 封止界面局所酸化 [SILO] または側壁マスク分離 [SWAMI][2026.01] |
| 10/17 | ・誘電材料を用いたトレンチ再充填により形成されるもの, 例: シャロ - トレンチ分離 [2026.01] |
| 10/20 | ・エアギャップ [2026.01] |
| 10/30 | ・PN 接合を含む分離領域 [2026.01] |
| 10/40 | ・多結晶半導体材料を含む分離領域 [2026.01] |
| 10/50 | ・電界効果に基づく分離領域 [2026.01] |
| 15/00 | 集積装置の高濃度にド - プされた埋め込み領域 [2026.01] |
| 20/00 | チップ, ウェハまたは基板における相互接続 [2026.01] |
| B | 配線パタ - ンの形成に関するもの |
| C | ・配線材料のエッチングによるもの |
| E | ・選択酸化によるもの |
| F | ・テ - パ - の形成に関するもの |
| G | ・リフトオフによるもの |
| K | 表面の平坦化に関するもの |
| Z | その他のもの |

注 [2026.01]

1. このグル - プは以下のものを包含する:
 - ・チップ内の相互接続;
 - ・ウェハ内またはウェハ上の相互接続;
 - ・基板内または基板上の相互接続。
 2. このグル - プはサブグル - プ H10W70/00 または H10W72/00 に包含される, パッケ - ジ基板内または上などの, パッケ - ジ内の相互接続を包含しない。
- | | |
|-------|--|
| 20/20 | ・ウェハ内部または基板内部にある相互接続, 例: シリコン貫通ビア [TSV][2026.01] |
| 20/40 | ・ウェハの外側または基板の外側にある相互接続, 例: バックエンド配線 [BEOL] のメタライゼ - ションまたはゲ - ト電極に接続しているビア [2026.01] |

- | | |
|-------|-------------------------------|
| V | 寄生効果, 例: 寄生チャネル, の除去に関するもの |
| W | 配線の交差に関するもの |
| Z | その他のもの |
| 20/41 | ・その導電部分に特徴のあるもの [2026.01] |
| A | 配線パタ - ン, 例: 配線の一般的構造, に関するもの |
| B | 配線層間の接続に関するもの |
| C | 配線層と半導体基板との接続に関するもの |
| Z | その他のもの |

20/42	...	ピア, 例. ピアプラグ [2026.01]	40/43	...	流動気体によるもの, 例. 強制空冷 [2026.01]
20/43	...	相互接続のレイアウト [2026.01]	40/43 100	...	空冷状態の変化の検出
20/44	...	導電部分の導電材料に特徴のあるもの [2026.01]	40/47	...	流動液体によるもの, 例. 強制水冷 [2026.01]
	M	主成分が金属材料であるもの	40/50	...	温度を感知するための構成 [2026.01]
	X	・Cu または Cu 合金を用いるもの	40/60	...	加熱構成または冷却構成を分離可能に取り付ける手段, 例. クランプ [2026.01]
	N	・Al または Al 合金を用いるもの		A	プリント基板との取付け
	R	・金属積層材を用いるもの		B	放熱板付シングルインライン型の取付け
	Q	金属及び半導体を併用するもの, 例. シリサイド, ポリサイド		C	位置規制
	P	半導体を用いるもの		D	圧接型
	Z	その他のもの		E	挟持による取付け
20/45	...	その絶縁部分に特徴のあるもの [2026.01]		F	接合層による取付け
	P	製造方法に特徴のあるもの		M	発熱体と放熱体間の熱伝導部材
	Q	・塗布によるもの		Z	その他
	R	・溶融処理, 例. リフロ -, を施すもの	40/70	...	容器内または封緘内における, 熱保護または熱制御のための充填材または補助部材 [2026.01]
	Z	その他のもの	40/73	...	相変化による冷却 [2026.01]
20/46	...	エアギャップを含むもの [2026.01]	40/73 100	...	沸騰冷却
20/47	...	異なる特性, 例. 異なる誘電率, を有する 2 つ以上の誘電層を含むもの [2026.01]	40/73 200	...	ヒートパイプ
20/48	...	絶縁部分の絶縁材料に特徴のあるもの [2026.01]	40/77	...	形状に特徴のある補助部材 [2026.01]
	K	無機材料によるもの	40/80	...	パッケ - ジの熱保護または熱制御のための回路構成 [2026.01]
	L	・金属化合物によるもの	42/00	...	装置の保護のための構成 (熱保護のための構成 H10W40/00) [2026.01]
	S	有機材料によるもの	42/00 100	...	機械的損傷からの保護
	Z	その他のもの	42/20	...	電磁波または粒子線からの保護, 例. 光, エックス線, ガンマ線または電子 [2026.01]
20/49	...	適用可能な相互接続, 例. ヒュ - ズまたはアンチヒュ - ズ [2026.01]	42/25	...	アルファ線からの保護, 例. 宇宙応用のためのもの [2026.01]
	S	配線以外の目的を有する導電層に関するもの, 例. シールド, ダミ -	42/40	...	改ざんからの保護, 例. 不正な検査またはリパ - スエンジニアリング [2026.01]
	T	配線終端部に関するもの, 例. ボンディングパッド	42/60	...	静電荷または静電気放電からの保護, 例. ファラデ - シールド (電気からの保護装置を備える集積装置 H10D89/60) [2026.01]
	U	ヒュ - ズ, アンチヒュ - ズ	42/80	...	過電流または過負荷からの保護, 例. ヒュ - ズまたは分路器 (電気からの保護装置を備える集積装置 H10D89/60) [2026.01]
	Z	その他のもの	42/80 100	...	過電圧からの保護
29/00	...	他に分類されない, 集積装置の一般的な部品 [2026.01]	44/00	...	インピーダンスを制御または整合させるための電氣的構成 [2026.01]
チップ, ウェハ, 基板またはパッケ - ジに関する構造上の細部 [2026.01]			44/20	...	高周波数 [HF] または無線周波数 [RF] における電氣的構成 [2026.01]
40/00	...	熱保護または熱制御のための構成 (熱からの保護装置を備える集積装置 H10D89/60) [2026.01]	46/00	...	装置に適用されるマ - ク, 例. 整列または識別するためのもの [2026.01]
40/00 100	...	製造または処理	46/00 101	...	前工程 [ウェハレベルまたはチップレベル] のマ - ク
40/00 900	...	恒温のための構成	46/00 201	...	後工程 [パッケ - ジレベル] のマ - ク
40/10	...	加熱のための構成 [2026.01]		注 [2026.01]	
40/20	...	冷却のための構成 [2026.01]		このグル - プは, チップ, ウェハ, 基板, パッケ - ジの内または上にあるマ - クを包含する。	
	A	半導体素子, 容器またはリ - ド		パッケ - ジの観点 [2026.01]	
	B	樹脂封止型	70/00	...	パッケ - ジ基板; インタ - ポ - ザ; 再配線層 [RDL][2026.01]
	C	放熱性回路基板またはステム		B	L, C または R を含む基板
	Z	その他		E	接地構造または電源接続構造に特徴のある基板
40/22	...	冷却のための構成の形状に特徴のあるもの, 例. 円錐または円筒の突出部を有するもの [2026.01]			
40/25	...	冷却のための構成の材料に特徴のあるもの [2026.01]			
40/28	...	ペルチェク - ラ - からなるもの [2026.01]			
40/30	...	パッケ - ジ全体が空気以外の流体中に浸されているもの, 例. 極低温流体の中に浸されているもの			
40/40	...	流動流体による熱交換を伴うもの [2026.01]			

F	チップを搭載するための構造に特徴のある基板	70/20	・配線として機能する導電性パッケ - ジ基板 , 例 . 金属板 (リ - ドフレ - ム H10W70/40)
R	・導電性接合材の流れ防止手段		
G	ガラス封止型装置の基板	70/40	・リ - ドフレ - ム [2026.01]
H	ハイブリッド IC 用基板	A	フレ - ム部または吊りリ - ド
J	放熱構造	B	・タブリ - ド
K	外部リ - ド取付けに特徴のある基板	D	メッキまたは半田付け
L	リ - ドレスチップキャリア	F	放熱
P	ピングリッドアレイ	G	モ - ルド
S	基板を構成する部品同士の接合に特徴があるもの	H	・耐電圧向上 , マイグレ - ション防止 , 耐湿性向上またはリ - ドの抜け防止
W	ワイヤボンディングに関連する基板構造	L	チップ搭載部材へのリ - ドの取付け
X	電磁シ - ルド材料	M	・リ - ドの取付部形状に特徴のあるもの
Z	その他	N	外部部材へのリ - ドの取付け
70/00 301	・高周波素子のマウント	R	小型化リ - ド
C	MIC 基板の取付け	S	チップとり - ドの接続
D	マイクロ波ダイオ - ドマウント	U	チップ搭載部
L	リ - ドインダクタンスの低減化	V	リ - ド用材料
Z	その他	Z	その他
70/00 501	・パッケ - ジ基板に突起状の電極を有するもの	70/40 100	・同軸タイプダイオ - ド
T	パッケ - ジ端子がボ - ル形状以外のもの	70/40 110	・全体に特徴のあるもの
B	突起状の電極によってチップをチップ幅より大きなパッケ - ジ基板と接続したもの	70/40 120	・ペレット固定 , 支持電極または電極保護
W	ワイヤによってチップをチップ幅より大きなパッケ - ジ基板と接続したもの	70/40 130	・リ - ド固定 , 一体リ - ドまたはモ - ルド
S	パッケ - ジ基板に対してパッケ - ジ端子とチップが同じ側にあるもの	70/40 140	・小型化リ - ド
C	パッケ - ジ基板がチップ幅以下のもの又はパッケ - ジ基板を有しないもの	70/40 200	・2 端子素子用 [同軸タイプダイオ - ド , 大電力用を除く]
V	・ワイヤまたはリ - ドを用いるもの	70/40 250	・3 端子素子用
Z	その他	70/40 300	・大電力用
70/01	・製造または処理 [2026.01]	70/40 310	・ケ - ス収納型用
70/02	・配線として機能する導電性パッケ - ジ基板の製造または処理 , 例 . 金属板 (リ - ドフレ - ムの製造または処理 H10W70/04)	70/40 400	・光素子用
70/04	・リ - ドフレ - ムの製造または処理 [2026.01]	70/40 500	・集積回路装置用
70/04 100	・同軸タイプダイオ - ド用	A	フレ - ム部または吊りリ - ド
70/04 250	・3 端子素子用	B	・タブリ - ド
70/04 500	・集積回路用	D	メッキ
B	リ - ドの成形または切断	E	半田付け
C	リ - ドの曲がり検出または整形	F	放熱
Z	その他	G	モ - ルド
70/05	・絶縁性パッケ - ジ基板 , インタ - ポ - ザまたは再配線層の製造または処理 (リ - ドフレ - ムの製造または処理 H10W70/04) [2026.01]	H	・耐電圧向上 , マイグレ - ション防止 , 耐湿性向上またはリ - ドの抜け防止
70/05 200	・セラミック基板またはガラス基板の製造または処理	J	・バリ除去
70/06	・一時的な補助支持体を用いるもの [2026.01]	L	チップ搭載部材へのリ - ドの取付け
70/08	・チップまたはウェハ上に層を堆積するもの , 例 . チップファ - スト RDL[2026.01]	M	・リ - ドの取付部形状に特徴のあるもの
70/09	・チップまたはウェハの横方向を取り囲む封止の上へ延長するもの , 例 . ファンアウトウェハレベルパッケ - ジ [FOWLP]RDL[2026.01]	N	外部部材へのリ - ドの取付け
		P	ピンタイプリ - ド
		R	小型化リ - ド
		S	チップとり - ドの接続
		T	・不要接触防止
		U	チップ搭載部
		V	リ - ド用材料
		W	積層フレ - ムまたは素子の相互接続のための端子構造
		X	端子配置または回路的特徴をもつもの
		Y	複数リ - ドの絶縁物による支持
		Z	その他

70/60		・絶縁性パッケ - ジ基板 ; インタ - ポ - ザ ; 再配線層 (リ - ドフレ - ム H10 W70/40) [2026.01]			このグル - プにおいては , ボンドパッド一般 , すなわち関連するコネクタの性質が特定されないまたは複数の種類のコネクタに対して汎用的な場合 , はグル - プ H10 W72/90 に分類される。 ? 特定の種類のコネクタに特に適合するボンドパッドは , そのコネクタの種類を包含するグル - プに分類される。例えば , ワイヤコネクタに特に適合するボンドパッドはグル - プ H10W72/59 に分類される。
70/60	500	・ ・ パッケ - ジ基板がフィルム状またはテープ状のもの			
70/62		・ ・ 絶縁性パッケ - ジ基板 , インタ - ポ - ザまたは再配線層の配線に特徴のあるもの [2026.01]			
70/62	500	・ ・ ・ 再配線層	72/20		・ バンプコネクタ , 例 . はんだバンプまたは銅ピラ - ; ダミ - バンプ ; サ - マルバンプ [2026.01]
70/63		・ ・ ・ ピア , 例 . ピアプラグ [2026.01]			
70/65		・ ・ ・ 配線の形状または配置 [2026.01]	72/20	101	・ ・ 構造に特徴
70/652		・ ・ ・ ・ 断面形状 [2026.01]		A	バンプの構造
70/654		・ ・ ・ ・ 上面視のレイアウト [2026.01]		G	絶縁膜 , 基板
70/655		・ ・ ・ ・ ・ ファンアウトのレイアウト [2026.01]		N	複数のバンプ電極の配置パタ - ンに特徴
70/656		・ ・ ・ ・ ・ ファンインのレイアウト [2026.01]		P	・ 特別の機能をもつバンプを選択的に配置
70/66		・ ・ ・ 配線の導電材料に特徴のあるもの [2026.01]		Q	・ 配置箇所に応じて形状を変化
70/67		・ ・ 絶縁性パッケ - ジ基板 , インタ - ポ - ザまたは再配線層の絶縁層または絶縁部分に特徴のあるもの [2026.01]		R	接続先の電極との形状・材質等の組み合わせに特徴
70/68		・ ・ ・ 絶縁層または絶縁部分の形状または配置 [2026.01]		Z	その他のもの
70/68	200	・ ・ ・ ・ セラミック基板またはガラス基板の形状または配置	72/20	102	・ ・ 材料・成分の選択に特徴
70/685		・ ・ ・ ・ 複数の絶縁層を含むもの [2026.01]		A	バンプの材料・成分
70/69		・ ・ ・ 絶縁層または絶縁部分の絶縁材料に特徴のあるもの [2026.01]		G	絶縁膜の材料・成分
70/69	100	・ ・ ・ ・ ダイヤモンド基板		Z	その他のもの
70/692		・ ・ ・ ・ セラミックまたはガラス [2026.01]	72/20	103	・ ・ 製造方法に特徴
70/695		・ ・ ・ ・ 有機材料 [2026.01]		A	バンプ自体の製造
70/698		・ ・ ・ ・ 電氣的に絶縁する半導体材料 , 例 . 非ド - プシリコン [2026.01]		B	バンプの載置
72/00		パッケ - ジ内の相互接続またはコネクタ [2026.01]		C	・ ボ - ルバンプの載置
72/00	101	・ フェイスボンディング [フリップチップ]		D	・ ワイヤボ - ル , すなわちスタッドバンプ , の製造・載置
	Q	フェイスボンディングによる接続		G	絶縁膜・フォトレジスト等の製造
	R	・ テ - プキャリアへの接続		Z	その他のもの
	S	・ 絶縁基板への接続 ; チップへの接続	72/20	104	・ ・ バンプによる接続 , フェイスボンディング [フリップチップ]
	T	フェイスボンディング装置	72/29		・ ・ するために特に適合するボンドパッド [2026.01]
	W	テ - プキャリア	72/29	101	・ ・ ・ パッド , 下地電極 [UBM] の構造に特徴
	Z	その他のもの	72/29	102	・ ・ ・ パッド , 下地電極 [UBM] の材料・成分の選択に特徴
72/00	102	・ 検査または測定に関するもの	72/29	103	・ ・ ・ パッド , 下地電極 [UBM] の製造方法に特徴
	Y	ボンディング検査または測定	72/30		・ ダイヤタッチコネクタ [2026.01]
	T	バンプ検査または測定		A	構造
	Z	その他のもの		B	・ 材料限定
72/00	103	・ その他のコネクタまたはボンディング		C	方法
	X	高周波用装置		D	・ 材料限定
	Z	その他のもの		E	接着材料
72/00	201	・ 圧力の適用を含むもの , 例 . 熱圧着結合		F	ダイボンディング装置
72/00	202	・ 機械振動 , 例 . 超音波振動 , の適用を含むもの		G	・ 接着材料の供給・塗布
72/00	203	・ チップの転写工程を含むもの		H	・ 局部に加熱手段
注 [2026.01]				J	圧接型
				Z	その他のもの
			72/40		・ 異方性導電接着材 [2026.01]
			72/49		・ ・ するために特に適合するボンドパッド [2026.01]
			72/50		・ ボンドワイヤ [2026.01]
				A	ワイヤによる内部接続
				B	・ 電極とリ - ドフレ - ムとの接続
				C	ワイヤのショ - ト防止
				D	ワイヤボンディング方法
				F	ワイヤボンディング用金属線

G	ワイヤボンディング装置の上部機構	A	アルファ線遮蔽のためのもの
H	・ワイヤボ - ル形成	E	遮光材使用
J	・ワイヤ張力調整; クランパ; ワイヤ供給	F	光半導体用
K	ワイヤボンディング装置の下部機構	Z	その他
L	ボンディング位置検知, 制御	74/43	・・・酸化物, 窒化物または炭化物を含むもの, 例 . セラミックまたはガラス [2026.01]
M	リ - ドフレ - ム側に特徴	74/43 100	・・・ガラス封止
Z	その他のもの	74/47	・・・有機材料を含むもの, 例 . 樹脂 [2026.01]
72/59	・・・そのために特に適合するボンドパッド [2026.01]	74/47 100	・・・複数の樹脂層
N	パッドの形状・配置に特徴	74/47 200	・・・エネルギー - 線官能樹脂, 例 . 光, 電子線またはイオン化線で硬化するもの
P	パッドの形状・配置以外に特徴	76/00	容器; 充填またはそのための補助部材; シ - ル [2026.01]
Z	その他のもの	76/01	・製造または処理 [2026.01]
72/60	・ストラップコネクタ, 例 . 電力装置を接地するための厚い銅クリップ [2026.01]	76/05	・・・容器中への充填, 例 . ガス充填 [2026.01]
E	ストラップコネクタがパッケ - ジ内部接続であるもの	76/10	・容器またはその部分 [2026.01]
V	ストラップコネクタがパッケ - ジ外部接続, すなわちピ - ムリ - ドとなるもの	S	電磁波遮蔽用
Z	その他のもの	A	放射線遮蔽用
72/90	・ボンドパッド一般 [2026.01]	E	混成集積回路用
74/00	封緘, 例 . 保護被覆 [2026.01]	F	光半導体用
74/01	・製造または処理 [2026.01]	H	高周波半導体素子用
R	樹脂封止	Y	超電導素子用
T	・トランスファ - 成形または射出成形によるもの	G	貫通孔を有するもの
B	・・・リ - ドフレ - ムの搬出入	J	蓋に特徴のあるもの
C	・樹脂ペレットまたはタブレット	K	緩衝部材を備えたもの
S	・樹脂シ - トを用いるもの	Z	その他
D	・バリ取り	76/12	・・・容器の形状に特徴のあるもの [2026.01]
E	・樹脂塗装	A	CAN 封止のもの
G	ガラス封止	B	平型のもの
F	樹脂またはガラス以外による封止	C	スタッド型のもの
H	リ - ドに特徴	D	外形に特徴のあるもの
J	光半導体用	E	リ - ドに関連するもの
Z	その他	Z	その他
74/10	・封緘の形状または配置に特徴のあるもの [2026.01]	76/13	・・・配線として機能する導電性基台を含む容器 [2026.01]
A	リ - ドに特徴	76/132	・・・導電性基台中の絶縁通路を通る他の配線を有するもの [2026.01]
B	放熱基板上のもの	76/134	・・・導電性基台に対して平行な他の配線を有するもの [2026.01]
T	絶縁基板の孔中に突出するリ - ドにチップを搭載したもの	76/136	・・・導電性基台に対して垂直な他の配線を有するもの [2026.01]
C	流れ防止手段	76/138	・・・導電性基台に対して平行な被覆板により形成される他の配線を有するもの, 例 . サンドイッチ型 [2026.01]
F	表面に導電層を有するもの	76/15	・・・絶縁性基台を含む容器 [2026.01]
G	熱収縮材を有するもの	76/153	・・・絶縁性基台を通る通路の中に配線を有するもの [2026.01]
H	表示または識別	76/157	・・・絶縁性基台に対して平行な配線を有するもの [2026.01]
J	外形に特徴	76/17	・・・容器の材料に特徴のあるもの [2026.01]
K	ケ - ス収納型	A	遮光材料
L	・ケ - ス収納型用封止材またはその配列	B	金属または導電材料
D	光半導体用	C	磁性材料
E	混成集積回路用	D	形状記憶合金
M	主として時計用	Z	その他
N	裏面のみの保護	76/18	・・・絶縁材料, 例 . 樹脂, ガラスまたはセラミック [2026.01]
Z	その他	A	樹脂容器
74/15	・・・フリップチップ装置の活性表面の上にあるもの, 例 . アンダ - フィル [2026.01]	B	ガラス容器
74/40	・封緘の材料に特徴のあるもの [2026.01]		

	C	セラミック容器
	D	・非酸化物を含むもの
	Z	その他
76/40		・容器の充填材または補助部材, 例: センタリング部材 (容器内または封緘内における, 熱保護または熱制御のための充填材または補助部材 H10W40/70) [2026.01]
76/42		・充填材 [2026.01]
76/43		・ガス状の充填材 [2026.01]
76/45		・液状の充填材 [2026.01]
76/47		・固体またはゲル状の充填材 [2026.01]
76/48		・湿気または他の望ましくない物質を吸収する, またはそれらと反応する材料を含む充填材 [2026.01]
76/60		・シ - ル [2026.01]
76/63		・シ - ルの形状または配置に特徴のあるもの, 例: 容器の蓋と壁の間のシ - ル [2026.01]
76/63 100		・ガラス材料を用いるもの
76/63 200		・金属材料を用いるもの
76/67		・シ - ルの材料に特徴のあるもの [2026.01]
76/67 100		・ガラス材料
76/67 200		・金属材料
76/67 300		・プリプレグ
78/00		動作中のパッケ - ジを支持するための, 分離可能な保持具 [2026.01]
	A	IC ソケット
	B	装着用治具または工具
	C	CAN 型または外部 3 端子型パワ - トランジスタの取付け
	D	支持, 接続または取付座
	E	トランジスタの取付けまたは支持工程 [半田付けを除く]
	Z	その他
80/00		チップ, ウェハまたは基板のダイレクトボンディング [2026.01]
	A	ハイブリッドボンディング; 絶縁部分と導電部分の同時直接接合
	Z	その他のもの

注 [2026.01]

このグル - プは以下のダイレクトボンディングを包含する:

- ・チップ同士, 例: チップ - トウ - チップ;
- ・装置および相互接続を内部または上部に有するウェハ同士, 例: ウェハ - トウ - ウェハ;
- ・装置および相互接続を内部または上部に有する基板同士;
- ・これらの組み合わせ, 例: チップ - トウ - ウェハ。

90/00		パッケ - ジ内の部品同士の相対的配置またはパッケ - ジ同士の相対的配置 [2026.01]
90/00 100		・組立体の製造または処理
90/00 200		・部品同士の位置合わせのための形状または構造
90/00 310		・光配線または光結合
90/00 320		・誘導結合または容量結合
90/00 330		・超電導配線または超電導素子を含むもの
90/00 400		・チップ間配線
	P	チップ間配線の製造または処理
	A	チップ間配線の形状, 構造またはレイアウト
	B	・チップ間が多層配線であるもの

	C	・立体的に配置されたマルチチップ間の配線
	D	・平面的に配置されたマルチチップ間の配線
	Z	その他
90/00 550		・複数のチップ搭載基板を含むもの
90/00 600		・少なくとも 1 つの半導体と他の固体装置からなる組立体
90/00 700		・ダイオ - ド組立体
90/00 750		・車両用のもの
90/00 800		・電力用モジュ - ル
90/00 910		・個別の容器または封止を有する装置を含む組立体
	A	ダイオ - ド組立体
	B	・車両用のもの
	C	・全てが直列的に接続されたもの
	D	スタッド形素子を含むもの
	Z	その他
90/00 912		・1 つの共通端子をもつもの
	A	加圧手段のあるもの
	Z	その他
90/00 914		・積み重ねられた配列
	A	平形半導体素子の加圧スタック
	B	・異なった素子を含むもの
	C	複数加圧スタックの組立体
	D	ダイオ - ド組立体
	Z	その他

注 [2026.01]

このグル - プは以下のものを包含する:

- ・単一のパッケ - ジ内における複数のチップの相対位置, 例: 単一の封緘内における複数のチップ;
- ・複数のパッケ - ジ内における複数のチップの相対位置, 例: 「パッケ - ジ - オン - パッケ - ジ」構成内において封緘されたチップが他の封緘されたチップ上にあるもの。

90/10		・横方向に隣接するチップの配置 [2026.01]
90/15		・横方向に隣接するチップが互いに異なる厚みを有するもの [2026.01]
90/20		・積層されたチップの配置 [2026.01]
	A	積層整流器
	B	チップ同士を突起状の電極により接続
	C	チップを貫通する導電性ビアによる接続
	K	基板, 容器または封止を貫通する導電性ビアによる接続
	E	複数チップの同一方向の面にワイヤ接続
	F	複数チップの反対方向の面にワイヤ接続
	G	バンパ接続チップ上にワイヤ接続チップを積層
	H	インタ - ボ - ザを用いる積層配置
	J	基板を折り曲げる積層配置
	Z	その他
90/20 100		・孔に貫通された 1 つ以上の棒状体上に取り付けられた孔あき装置
90/22		・チップがパッケ - ジ基板, インタ - ボ - ザまたは RDL の上面と下面の両方にあるもの [2026.01]
90/24		・積層されたチップの少なくとも 1 つが, 隣接するチップから水平方向にオフセットしているもの, 例: 階段状のもの [2026.01]

90/26	<ul style="list-style-type: none"> .. 同じサイズのチップが積層され , いずれのチップも水平方向にオフセットしないもの , 例 . 長方形状のもの [2026.01]
90/28	<ul style="list-style-type: none"> .. 異なるサイズのチップが積層されたもの , 例 . ピラミッド型のもの [2026.01]
95/00	<p>このサブクラスの他のグル - プに包含されないパッケ - ジング方法 [2026.01]</p> <ul style="list-style-type: none"> A 組立 B ・少なくともダイボンディングとワイヤボンディングを含む組立 C 部品の移送・供給 D ・リ - ドフレ - ムの移送・供給 E リ - ドフレ - ムの収納 F 部品の位置決め G 封止 H めっき J 加熱 Z その他のもの
99/00	<p>このサブクラスの他のグル - プに包含されない主題事項 [2026.01]</p>
